

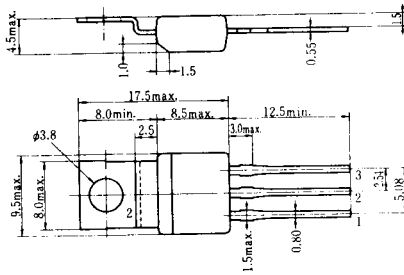
2SD757, 2SD758

シリコン NPN エピタキシャル形

低周波高電圧増幅用
2SB717, 2SB718とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER
Complementary pair with 2SB717 and 2SB718



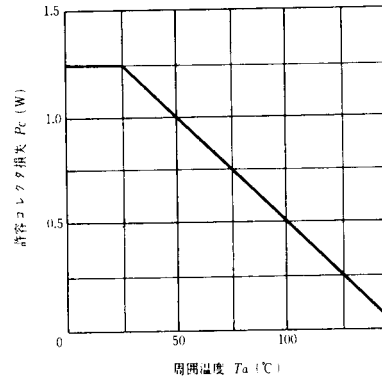
(JEDEC TO-202AA MOD.)

1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD757	2SD758	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}		160	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}		160	200	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}		5	5	V
コレクタ電流	I_C		50	50	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$		100	100	mA
許容コレクタ損失	P_C		1.25	1.25	W
接合部温度	T_j		150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{sig}		-45~+150	-45~+150	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	2SD757			2SD758			Unit
				min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$		$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	160	—	—	200	—	—	
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	160	—	—	200	—	—	
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	5	—	—	
コレクタ遮断電流	I_{CBO}		$V_{CB}=140\text{V}, I_E=0$	—	—	10	—	—	—	
			$V_{CB}=160\text{V}, I_E=0$	—	—	—	—	—	10	
直流電流増幅率	h_{FE1}^*		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	60	—	320	60	—	320	
	h_{FE2}		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	30	—	—	30	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	—	1.5	—	—	1.5	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$		$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}$	—	—	2	—	—	2	
利得帯域幅積	f_T		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	—	140	—	—	140	—	M
コレクタ出力容量	C_{ob}		$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	3.8	—	—	3.8	—	

*2SD757, 2SD758は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

*The 2SD757 and 2SD758 are grouped by h_{FE1} as follows.

B	C	D
60~120	100~200	160~320